

★レーザ・量子エレクトロニクス研究会 (LQE)

専門委員長 野田 進 副委員長 山本剛之

幹事 藤原直樹・片桐崇史

日時 12月16日(金) 10:00~15:20

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 半導体レーザ関連技術, 及び一般

1. 9xxnm 帯高出力ブロードエリアレーザダイオードにおける光出力飽和とその改善
○山形友二(オプトエナジー)・貝淵良和・能川亮三郎・諸橋倫太郎(フジクラ)・山田由美(オプトエナジー)・山口昌幸(フジクラ)
2. L帯 SOA 集積型 EADFB レーザ () による伝送距離延伸及び高変調時出力動作化
○進藤隆彦・小林 亘・藤原直樹・大磯義孝・長谷部浩一・石井啓之・井藤幹隆 (NTT)

◎若手奨励賞授賞式

3. [記念講演] フォトニック結晶ナノ共振器量子ドットレーザによる高機能ナノ光源
○太田泰友・岩本 敏・荒川泰彦(東大)
4. [記念講演] 光音響・発光同時計測及び時間分解発光計測による窒化物半導体の内部量子効率と輻射・非輻射再結合寿命の測定 河上航平・中納 隆・○山口敦史(金沢工大)

午後(13:10~)

5. [招待講演] 半導体レーザ会議2016報告 東盛裕一(ツルギフォトンクス財団)
6. [招待講演] 光デバイス集積技術 西山伸彦(東工大)
7. [招待講演] 光デバイス実装の動向 ○有賀 博・望月啓太・村尾覚志・白尾瑞樹(三菱電機)
8. [招待講演] InP系モノリシック集積光デバイス—これまでと今後の展望—
○八木英樹・金子俊光・吉永弘幸・小路 元(住友電工)
9. [招待講演] シリコンフォトンクス集積デバイス技術 田中 有(PETRA)

◎ディスカッション

☆LQE 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

2017年1月18日(水), 19日(木) (開催日変更) 伊勢市観光文化会館〔未定〕テーマ: フォトニックNW・デバイス, フォトニック結晶, ファイバとその応用, 光集積回路, 光導波路素子, 光スイッチング, 導波路解析, マイクロ波・ミリ波フォトンクス, 及び一般

【問合先】

藤原直樹 (NTT)

TEL [046] 240-3266, FAX [046] 240-4345

E-mail: fujiwara.naoki@lab.ntt.co.jp

片桐崇史 (東北大学院)

TEL [022] 795-7107, FAX [022] 795-7106

E-mail: katagiri@ecei.tohoku.ac.jp

◎LQE 研究会ホームページ

<http://www.ieice.org/~lqe/jpn/>

◎LQE 研究会では平成18年度より「LQE 奨励賞」を設けました。対象は発表年度の4月1日時点で32歳以下の若手研究者(学生を含む)です。積極的に御投稿下さい。